

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING EQUIPMENT

Patent Number: JP9251981

Publication date: 1997-09-22

Inventor(s): KURIHARA KAZUAKI; SEKINE MAKOTO; OKUMURA KATSUYA

Applicant(s):: TOSHIBA CORP

Requested Patent: JP9251981

Application Number: JP19960057970 19960314

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L21/3065 ; B01J3/02 ; C23C16/50 ; C23F4/00 ; H01L21/203 ; H01L21/205

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance usage efficiency of process gas under a decompressed atmosphere of an etching device, etc., and reduce production cost by a method wherein the process gas is supplied to the interior of a vacuum bath for discharging the inside and decompressing and a part of exhaust gas is recirculated from the exhaust side to the interior of the vacuum bath.

SOLUTION: A nozzle incorporated into an anode electrode 103 in a vacuum bath 101 is connected to a gas bomb 111 being a supply source of process gas, and the exhaust side 105a of a turbo-molecule pump connecting with the vacuum bath 101 is connected with a dry pump 106. Further, in the intermediate side of a recirculation line 107 provided between the exhaust side 105a of the turbo-molecule pump and the vacuum bath 101, a valve 108 and a filter 113 are disposed. A part of the process gas discharged by a turbo-molecule pump 105 from inside of the vacuum bath 101 is returned to the vacuum bath 101 through the recirculation line 107. A ratio of this process gas recirculated is adjusted by the degree of opening of the valve 108.

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-251981

《43》公開日 平成9年(1997)9月22日

(51)Int.Cl. ¹	識別記号	序内整理番号	P I	技術表示箇所
H 01 L	21/3065		H 01 L	21/302
B 01 J	3/02		B 01 J	3/02
C 23 C	16/50		C 23 C	16/50
C 23 F	4/00		C 23 F	4/00
H 01 L	21/203		H 01 L	21/203

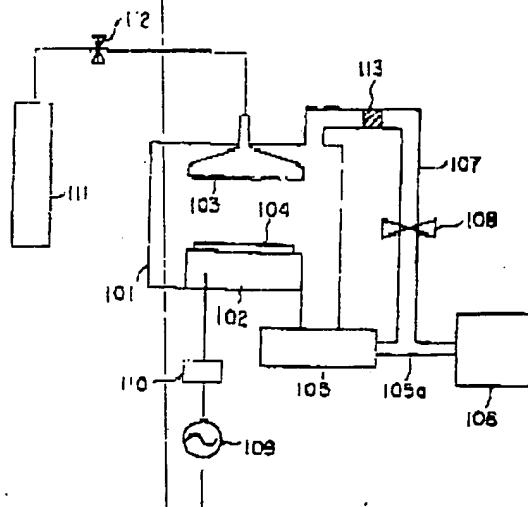
(21)出願番号	特願平8-57970	(71)出願人	000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区横川町72番地
(22)出願日	平成8年(1996)3月14日	(72)発明者	栗原 一郎 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内
		(72)発明者	鶴根 駿 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内
		(72)発明者	栗村 駿介 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦

(54) **【発明の名称】** 半導体回路装置

(57) **【要約】**

【課題】 半導体製造装置においてプロセスガスの利用効率の向上を図る。

【解決手段】 本発明の半導体製造装置は、真空槽101と、真空槽101の内部を排気して減圧するターボ分子ポンプ105と、ターボ分子ポンプの排気側105aを更に排気して減圧するドライポンプ106と、真空槽101の内部にプロセスガスを供給するガスホンベ111と、ターボ分子ポンプ105によって排気されたガスの一部を、ターボ分子ポンプの排気側105aから真空槽101の内部へ再循環させる再循環ライン107と、を備える。



BEST AVAILABLE COPY